Technologie salle blanche et caractérisation

Réalisation du circuit intégré MOSTEC Diodes diffusées

Mohamed Hage Hassan Lucien Dos Santos Nathanal Marty Ayoub Bargach Benjamin Bony

14 Mars, 2017

Table des matières

| 1 | Intr | roduction | 2 |
|---|------------------|--|----------|
| 2 | Première scéance | | |
| | 2.1 | Observation zones actives et nettoyage des plaques | 2 |
| | 2.2 | Oxydation thermique | |
| | 2.3 | Modélisation dopage | 2 |
| | 2.4 | Étude oxyde de champ | 2 |
| | 2.5 | Étude dopage : R-carré | 2 |
| | 2.6 | Retrait du verre de phosphore | 2 |
| | 2.7 | Présentation Pulvérisation cathodique | 2 |
| | 2.8 | Dépot Aluminium : R-carré Alu | 2 |
| 3 | Deuxième scéance | | 2 |
| | 3.1 | Etalement résine, photolithographie | 2 |
| | 3.2 | Gravure humide de l'aluminium | 2 |
| | 3.3 | Nettoyage RIE face arrière | 2 |
| | 3.4 | Mesure de motif profilomètre | 2 |
| 4 | Con | nclusion | 2 |

1 Introduction

- 2 Première scéance
- 2.1 Observation zones actives et nettoyage des plaques
- 2.2 Oxydation thermique
- 2.3 Modélisation dopage
- 2.4 Étude oxyde de champ
- 2.5 Étude dopage : R-carré
- 2.6 Retrait du verre de phosphore
- 2.7 Présentation Pulvérisation cathodique
- 2.8 Dépot Aluminium : R-carré Alu
- 3 Deuxième scéance
- 3.1 Etalement résine, photolithographie
- 3.2 Gravure humide de l'aluminium
- 3.3 Nettoyage RIE face arrière
- 3.4 Mesure de motif profilomètre
- 4 Conclusion